

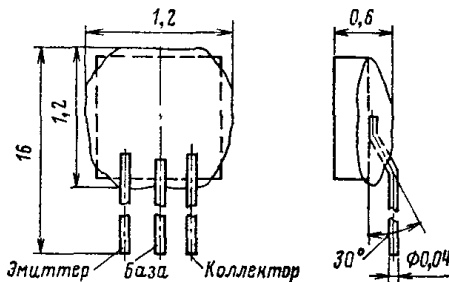
2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, 2Т332Г-1, 2Т332Д-1, КТ332А-1, КТ332Б-1, КТ332В-1, КТ332Г-1, КТ332Д-1

Транзисторы кремниевые планарные *n-p-n* высокочастотные и СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 100 МГц.

Предназначены для усиления и генерирования сигналов высокой частоты.

Бескорпусные, без кристаллодержателя, с гибкими выводами и защитным покрытием эмалью. Выпускаются в сопроводительной таре. Обозначение типа приводится на этикетке.

Масса транзистора не более 0,003 г.



Электрические параметры

Граничная частота при $U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 3$ мА не менее:

2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, КТ332А-1, КТ332Б-1, КТ332В-1	250 МГц
2Т332Г-1, 2Т332Д-1, КТ332Г-1, КТ332Д-1	500 МГц
типичное значение:	
2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1	450 * МГц
2Т332Г-1, 2Т332Д-1	550 * МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 1$ мА, $f = 5$ МГц не более 300 пс
 типовое значение 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, 2Т332Г-1, 2Т332Д-1 80 * пс

Минимальный коэффициент шума при $U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 1$ мА, $f = 100$ МГц не более 8 дБ
 типовое значение 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, 2Т332Г-1, 2Т332Д-1 5 * дБ

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 1$ мА:
 при $T = 298$ К:
 2Т332А-1, КТ332А-1 20—60

Материал взят из источника:

2Т332Б-1, 2Т332Г-1, КТ332Б-1, КТ332Г-1	40–120
2Т332В-1, 2Т332Д-1, КТ332В-1, КТ332Д-1	80–220
при $T = 213$ К	
2Т332А-1	10–60
2Т332Б-1, 2Т332Г-1	15–120
2Т332В-1, 2Т332Д-1	30–240
при $T = 398$ К	
2Т332А-1	20–130
2Т332Б-1, 2Т332Г-1	40–250
2Т332В-1, 2Т332Д-1	80–500
Постоянное прямое напряжение эмиттер-база при $U_{КБ} =$ $= 5$ В, $I_{Э} = 1$ мА	0,55–0,75 В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 15$ В не более	
при $T = 298$ К	0,2 мкА
при $T = 398$ К 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, 2Т332Г-1, 2Т332Д-1	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 3$ В не более	
при $T = 298$ К	0,5 мкА
при $T = 398$ К 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, 2Т332Г-1, 2Т332Д-1	10 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{ЭБ} = 5$ В не более	5 пФ
типое значение 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, 2Т332Г-1, 2Т332Д-1	3* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 1$ В не более	8 пФ
типое значение 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, 2Т332Г-1, 2Т332Д-1	5* пФ

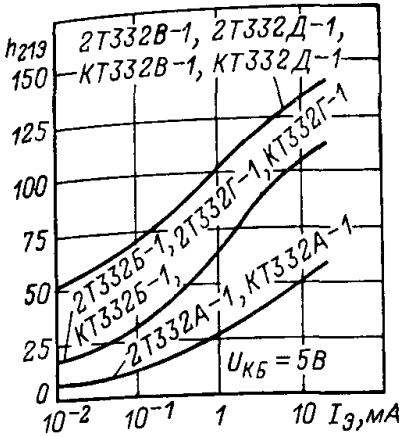
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер	
при $R_{ЭБ} \leq 10$ кОм	15 В
при $R_{ЭБ} \leq 100$ кОм 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, 2Т332Г-1, 2Т332Д-1	10 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	3 В
Постоянный ток коллектора	20 мА
Постоянный ток базы	5 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 10$ мкс	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	
при $T = 213 - 358$ К 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, 2Т332Г-1, 2Т332Д-1	15 мВт
при $T = 213 - 348$ К КТ332А-1, КТ332Б-1, КТ332В-1, КТ332Г-1, КТ332Д-1	15 мВт
при $T = 398$ К	
2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, 2Т332Г-1, 2Т332Д-1	3 мВт
КТ332А-1, КТ332Б-1, КТ332В-1, КТ332Г-1, КТ332Д-1	2,5 мВт

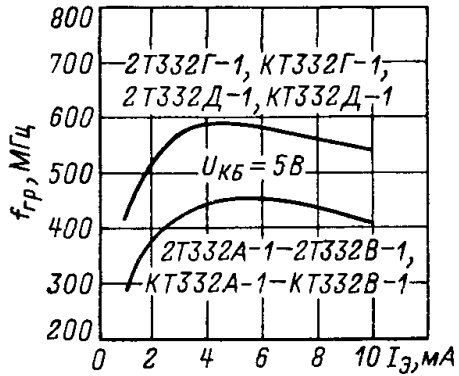
Материал взят из источника:

Общее тепловое сопротивление:

2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, 2Т332Г-1,	
2Т332Д-1	3300 К/Вт
КТ332А-1, КТ332Б-1, КТ332В-1, КТ332Г-1,	
КТ332Д-1	4000 К/Вт
Температура перехода	408 К
Температура окружающей среды	От 213
	до 398 К



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



Зависимость граничной частоты от тока эмиттера.

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985